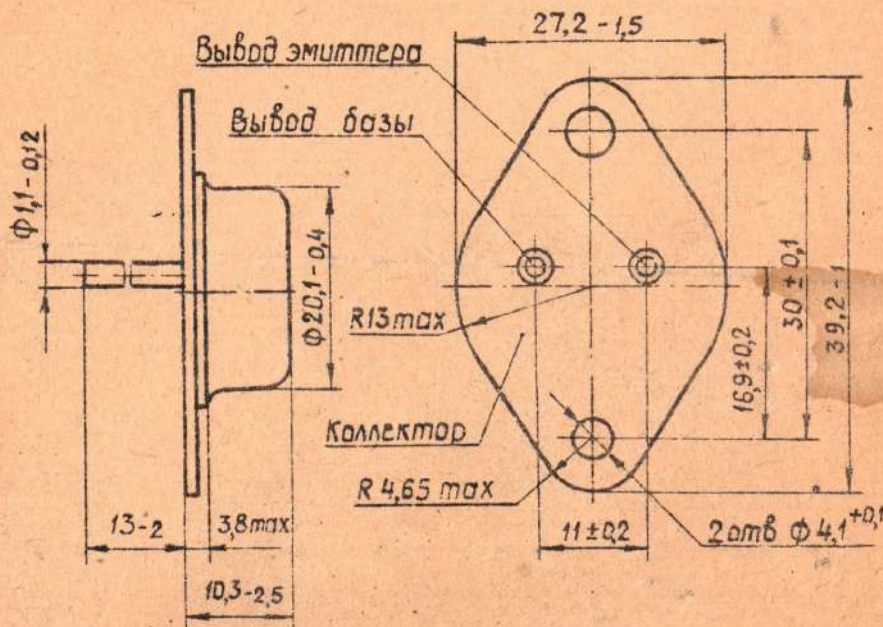


ЭТИКЕТКА



Транзисторы типов
КТ825Г, КТ825Д, КТ825Е
соответствуют
ГОСТ 11630-84 и техническим
условиям АА0.336.306 ТУ



Масса не более 20 г

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. транзисторов

Золото _____

Серебро _____

1. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ
 $t_{корп.} = +25^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения тип транзистора	Буквенное обозначение	Н о р м а
		не менее
1. Пробивное напряжение коллектор-эмиттер, В. $I_K = 1 \text{ мА}, R_{63} \pm 1 \text{ кОм}$ КТ825Г КТ825Д КТ825Е	$U_{кз.проб}$	90 60 30
2. Пробивное напряжение эмиттер-база, В. $I_E = 2 \text{ мА}$ КТ825Г-КТ825Е	$U_{эб.проб}$	5
3. Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером $U_{кб} = 10 \text{ В}, I_E = 5 \text{ А}$ КТ825Г-КТ825Е	$h_{21э}$	750

Место штампа ОТК

Место штампа

Государственной приемки

